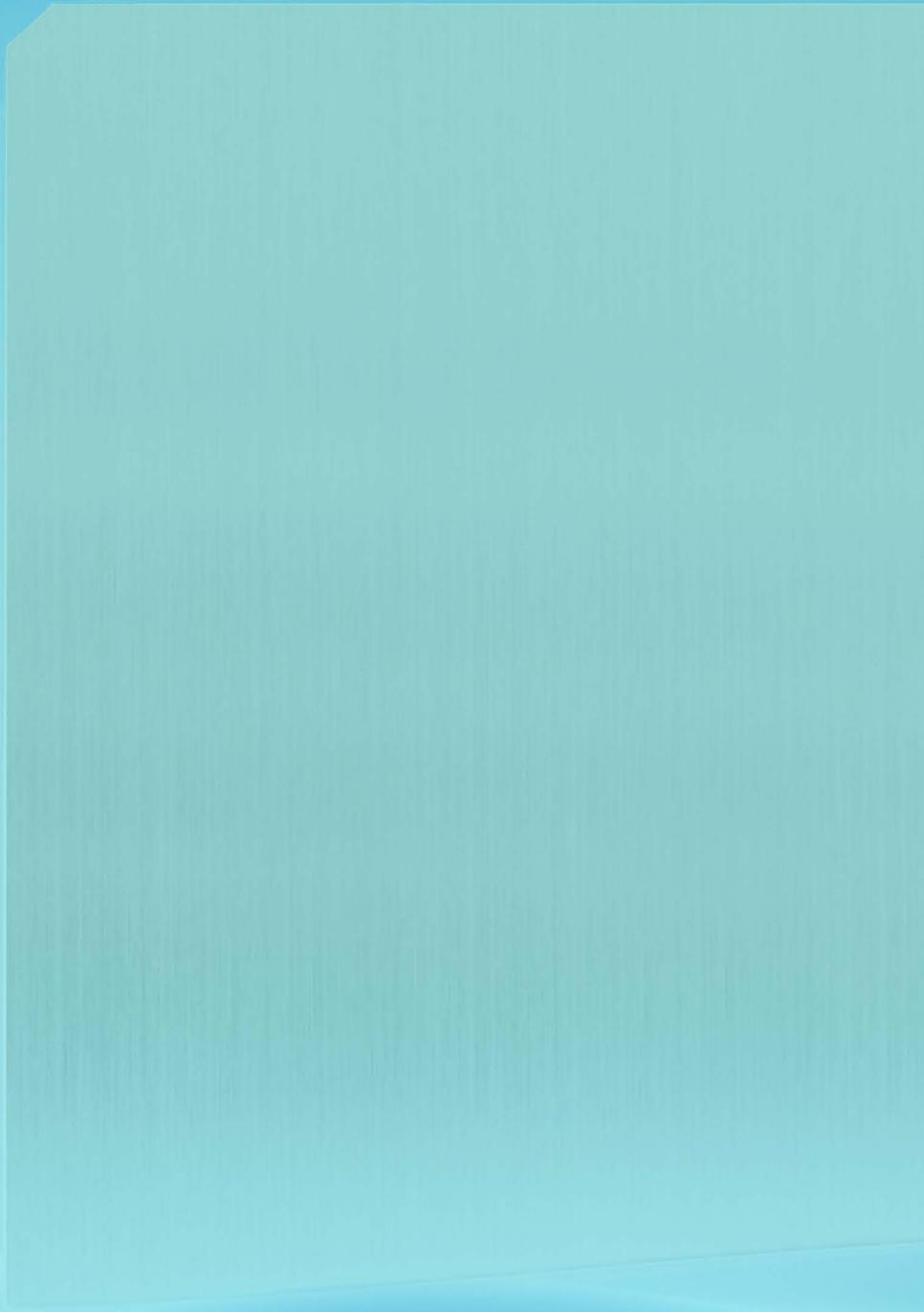


HYSOLAR G12R

单晶硅片

N型-G12R / 210*182



弘元新材料（包头）有限公司

地址：包头装备制造产业园新材料产业园西大街1号

网址：www.hysolar.com

邮箱：sales@hysolar.com

关键参数

硅片型号	G12R
导电类型	N型
掺杂元素	P (磷)
电阻率	0.4 ~ 1.6Ω • cm
少子寿命	≥1000μs
氧含量	≤12ppma

倒角边形状

硅片边距

- “ 40.0 ± 0.10mm

倒角边形状



倒角边形状



直角

短边182.5 ± 0.10mm

- “ 182.5 ± 0.10mm
- “ 182.5 ± 0.10mm
- “ 182.5 ± 0.10mm
- “ 182.5 ± 0.10mm
- “ 182.5 ± 0.10mm
- “ 182.5 ± 0.10mm
- “ 182.5 ± 0.10mm
- “ 182.5 ± 0.10mm
- “ 182.5 ± 0.10mm
- “ 182.5 ± 0.10mm

短边182.5 ± 0.10mm

